- 控制信号：包括片选、时钟、时钟有效、行/列地址选择、读/写选择、数据有效；
- 地址：时分复用管脚，根据行/列地址选择管脚控制输入地址为行地址或列地址；
- 数据：双向管脚，由数据有效控制。

根据控制信号和地址输入，SDRAM 包括多种输入命令：模式寄存器设置、激活、预充、写、读等命令。根据输入命令，SDRAM 状态在内部状态间转换。内部状态包括：模式寄存器设置、激活、写、读等状态。

3.2.7 Flash RAM 芯片

AT49F002 是 Atmel 公司出品 Flash RAM，它的容量为 256K×8bit，采用 CMOS 工艺，快速读取时间达到 55ns，存储时间约 90ns，快速擦写周期为 10s。